

CONCLUSION GENERALE

Dans ce travail, nous présentons une approche théorique basée sur des modèles de mobilité dans le silicium monocristallin dopé par des atomes accepteurs (piézorésistance type P), l'objet et d'étudier la variation de la mobilité en fonction de la température et du dopage.

Sachant que la mobilité dépend du dopage et de la température, il est évident que les quatre piézorésistances du capteur de pression dépendent également.

Cette analyse se focalise aussi sur le comportement de la tension d'offset en fonction de la température. Elle permet de relier les coefficients thermiques étudiés à celui de la dérive thermique de la tension d'offset. Pour cela, nous avons tracé la variation de la tension d'offset en fonction de la température où nous avons comparé nos résultats simulés avec des résultats expérimentaux trouvés précédemment.

PERSPECIVES

Dans cet aspect de modélisation, il est envisageable de poursuivre de façon systématique le développement et l'implantation de modèles plus complexes.